

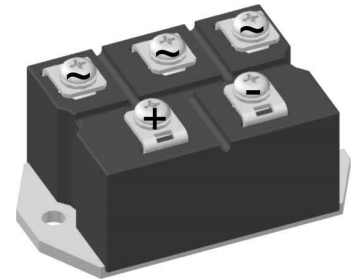
# Standard Rectifier Module

<b>3~ Rectifier</b>	
$V_{RRM}$	= 1200 V
$I_{DAV}$	= 60 A
$I_{FSM}$	= 550 A

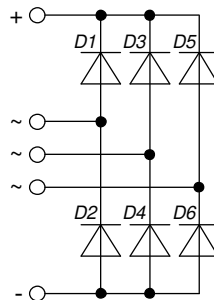
## 3~ Rectifier Bridge

Part number

**VUO62-12N07**



 E72873



### Features / Advantages:

- Package with DCB ceramic
- Improved temperature and power cycling
- Planar passivated chips
- Very low forward voltage drop
- Very low leakage current

### Applications:

- Diode for main rectification
- For three phase bridge configurations
- Supplies for DC power equipment
- Input rectifiers for PWM inverter
- Battery DC power supplies
- Field supply for DC motors

### Package: PWS-D

- Isolation Voltage: 3000 V~
- Industry standard outline
- RoHS compliant
- Easy to mount with two screws
- Base plate: Copper internally DCB isolated
- Advanced power cycling

### Disclaimer Notice

Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, users should independently evaluate the suitability of and test each product selected for their own applications. Littelfuse products are not designed for, and may not be used in, all applications. Read complete Disclaimer Notice at [www.littelfuse.com/disclaimer-electronics](http://www.littelfuse.com/disclaimer-electronics).



Rectifier				Ratings			
Symbol	Definition	Conditions		min.	typ.	max.	Unit
$V_{RSM}$	max. non-repetitive reverse blocking voltage					1300	V
$V_{RRM}$	max. repetitive reverse blocking voltage					1200	V
$I_R$	reverse current	$V_R = 1200$ V		$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$		40	$\mu\text{A}$
		$V_R = 1200$ V		$T_{VJ} = 150^\circ\text{C}$		1.5	mA
$V_F$	forward voltage drop	$I_F = 20$ A		$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$		1.07	V
		$I_F = 60$ A				1.30	V
		$I_F = 20$ A		$T_{VJ} = 125^\circ\text{C}$		0.96	V
		$I_F = 60$ A				1.27	V
$I_{DAV}$	bridge output current	$T_C = 120^\circ\text{C}$		$T_{VJ} = 150^\circ\text{C}$		60	A
		rectangular	$d = \frac{1}{3}$				
$V_{FO}$	threshold voltage			$T_{VJ} = 150^\circ\text{C}$		0.78	V
$r_F$	slope resistance					8.1	m $\Omega$
						} for power loss calculation only	
$R_{thJC}$	thermal resistance junction to case					1.1	K/W
$R_{thCH}$	thermal resistance case to heatsink				0.4		K/W
$P_{tot}$	total power dissipation			$T_C = 25^\circ\text{C}$		110	W
$I_{FSM}$	max. forward surge current	$t = 10$ ms; (50 Hz), sine		$T_{VJ} = 45^\circ\text{C}$		550	A
		$t = 8,3$ ms; (60 Hz), sine		$V_R = 0$ V		595	A
		$t = 10$ ms; (50 Hz), sine		$T_{VJ} = 150^\circ\text{C}$		470	A
		$t = 8,3$ ms; (60 Hz), sine		$V_R = 0$ V		505	A
$I^2t$	value for fusing	$t = 10$ ms; (50 Hz), sine		$T_{VJ} = 45^\circ\text{C}$		1.52	kA <sup>2</sup> s
		$t = 8,3$ ms; (60 Hz), sine		$V_R = 0$ V		1.48	kA <sup>2</sup> s
		$t = 10$ ms; (50 Hz), sine		$T_{VJ} = 150^\circ\text{C}$		1.11	kA <sup>2</sup> s
		$t = 8,3$ ms; (60 Hz), sine		$V_R = 0$ V		1.06	kA <sup>2</sup> s
$C_J$	junction capacitance	$V_R = 400$ V; $f = 1$ MHz		$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$		19	pF



Package PWS-D			Ratings			
Symbol	Definition	Conditions	min.	typ.	max.	Unit
$I_{RMS}$	RMS current	per terminal			150	A
$T_{VJ}$	virtual junction temperature		-40		150	°C
$T_{op}$	operation temperature		-40		125	°C
$T_{stg}$	storage temperature		-40		125	°C
<b>Weight</b>				159		g
$M_D$	mounting torque		4.25		5.75	Nm
$M_T$	terminal torque		4.25		5.75	Nm
$d_{Spp/App}$	creepage distance on surface   striking distance through air	terminal to terminal	9.5			mm
$d_{Spb/Apb}$		terminal to backside	26.0			mm
$V_{ISOL}$	isolation voltage	t = 1 second	3000			V
		t = 1 minute	2500			V



Ordering	Ordering Number	Marking on Product	Delivery Mode	Quantity	Code No.
Standard	VUO62-12NO7	VUO62-12NO7	Box	10	460451

**Equivalent Circuits for Simulation**

\* on die level

$T_{VJ} = 150^{\circ}C$



**Rectifier**

$V_{0\ max}$	threshold voltage	0.78	V
$R_{0\ max}$	slope resistance *	6.9	mΩ





**Rectifier**

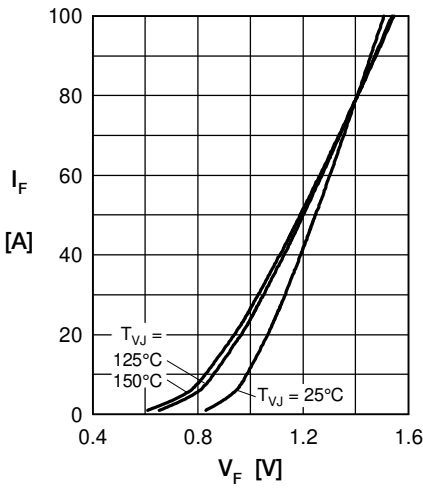


Fig. 1 Forward current vs. voltage drop per diode



Fig. 2 Surge overload current vs. time per diode



Fig. 3  $I^2t$  vs. time per diode

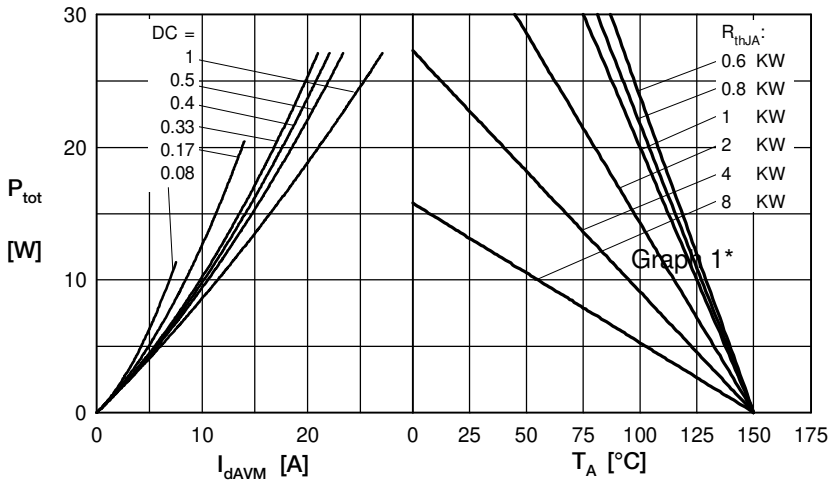


Fig. 4 Power dissipation vs. forward current and ambient temperature per diode



Fig. 5 Max. forward current vs. case temperature per diode

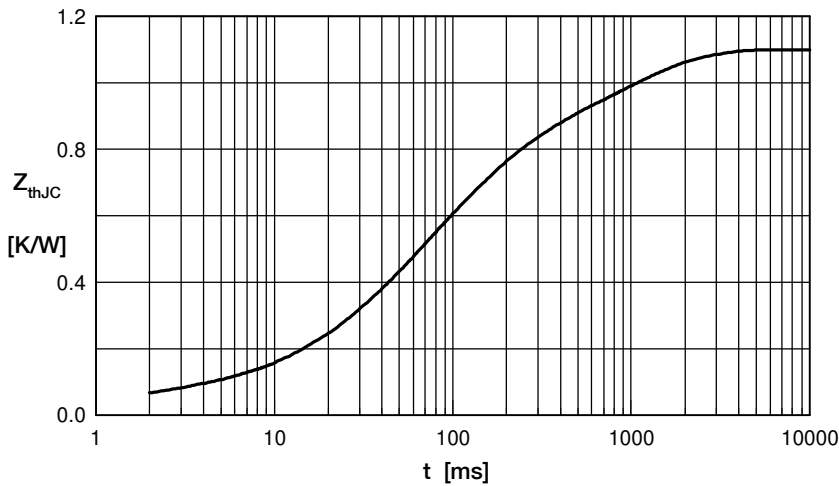


Fig. 6 Transient thermal impedance junction to case vs. time per diode

Constants for  $Z_{thJC}$  calculation:

i	$R_{th}$ (K/W)	$t_i$ (s)
1	0.05	0.001
2	0.14	0.030
3	0.25	0.060
4	0.35	0.130
5	0.31	0.920

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9